







	<h2 style="color: red;">FQP3N80C</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP3N80C</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 3A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP3N80C.pdf 2.FQP3N80C.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 37146 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP3N80C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 3A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	37146 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	28 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 3A (Tc) 107W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	107W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.8 Ohm @ 1.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	705pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQP3N80C-ND

FQP3N80C ist neu im Original, Suche FQP3N80C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP3N80C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP3N80C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP3N60C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3A TO-220</p>	 <p>FQP3N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 3.6A TO-220</p>	 <p>FQP3P20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.8A TO-220</p>	 <p>FQP3N90 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 3.6A TO-220</p>
 <p>FQP3N60C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3A TO-220</p>	 <p>FQP3N80C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A TO-220</p>	 <p>FQP3N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A TO-220</p>	 <p>FQP3P50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 2.7A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ FQP2N60B	↔ FQP2N60C	⇒ FQP2N60C	D FQP2N65C	↔ FQP30N06
⊕ FQP30N06	⊕ FQP30N06L	D FQP30N06L	⇒ FQP32N12V2	↔ FQP32N12V2
⊕ FQP32N20	⊕ FQP32N20C	⊕ FQP32N20C	↔ FQP33N10	↔ FQP33N10
D FQP33N10L	⊕ FQP33N10L	⊕ FQP34N20	⊕ FQP34N20	↔ FQP34N20L
⇒ FQP34N20L	↔ FQP3N50C	⊕ FQP3N60C	⊕ FQP3N60C	↔ FQP3N80C
↔ FQP44N08	⇒ FQP44N08	D FQP44N10	⊕ FQP44N10	⊕ FQP44N10F
⊕ FQP44N10F	D FQP45N03L	⇒ FQP45N03LM	↔ FQP45N15V2	↔ FQP45N15V2
⊕ FQP45N20A	⊕ FQP46N15	↔ FQP46N15	⇒ FQP47N06	↔ FQP47P06
⊕ FQP47P06	⊕ FQP47P06L	⊕ FQP47P06_	D FQP47P06_NW82049	↔ FQP47P06_NW82049
↔ FQP47P06_SW82049	⊕ FQP47P06_SW82049	⊕ FQP4N20L	⊕ FQP4N20L	↔ FQP4N60C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

